LASER PROCESSING DEVICE

Publication number:

JP3128186

Publication date:

1991-05-31

Inventor:

OGAWA HIROYUKI

Applicant:

TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO

Classification:

- international:

B23K26/04; B23K26/04; (IPC1-7): B23K26/04

- european:

Application number: Priority number(s):

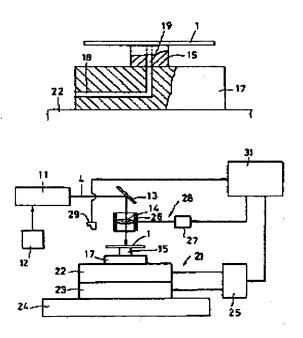
JP19890265260 19891013

JP19890265260 19891013

Report a data error here

Abstract of JP3128186

PURPOSE:To improve processing efficiency by constituting the laser processing device in such a manner thant the deviation in the focal position of a laser beam by the warpage generated in a work is corrected to execute processing. CONSTITUTION: The laser processing device for a semiconductor wafer 1 as the work held on a holder 15 is constituted of a 1st driving mechanism 21 in the X- and Ydirections of the holder 15, a laser oscillator 11, an optical system 14 for focusing and projecting the laser beam to the work 1, a 2nd driving mechanism 28 for changing the focal position of the laser beam, a work height detector 29, and a control section 31 which detects and computes the height over the entire area on the front surface of the work and controls the 2nd driving mechanism. The laser processing of the warped work 1 by maintaining the specified focal position with respect to the work is executed in this way and the efficiency is improved.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

3/4

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

平3-128186

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)5月31日

B 23 K 26/04

C 7920-4E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

会発明の名称

レーザ加工装置

②特 願 平1-265260

②出 願 平1(1989)10月13日

@発明者 小川

裕ク

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株式会社東芝生産

技術研究所内

⑪出 願 人 株 式 会 社 東 芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

個代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外3名

明 和 書

1. 発明の名称

レーザ加工装置

2. 特許請求の範囲

3. 危明の詳細な説明

(発明の目的)

(産業上の利用分野)

この発明は半導体ウエハをレーザ光でスクライピング加工するのに好適するレーザ加工装置に関する。

(従来の技術)

半導体ウエハをレーザ光でスクライビング加 工する場合、通常、第6図に示すように半導体ウエハ1上でレーザ光をaで示すように走査させて 一方向(X方向)に沿う所定ピッチの満加工をし たのち、つぎにbで示すように上記X方向と直交 するY方向に所定ピッチで走査させて満加工する ようにしている。

ところで、このようなスクライビング加工をする場合、加工時の熱応力によって半導体ウェハに生じる変形や反りを矯正する状態で周辺部を強固にクランプすると、上記半導体ウェハが割れてしまう恐れがある。そこで、半導体ウェハの中心部分だけを保持具によって真空吸着するということ

FP03-0350 '06.10.03 **OA** IF

特開平3-128186(2)

が考えられている。

ところで、半導体ウエハをレーザ光によってスクライビング加工する場合、通常は第1の方法として半導体ウエハの厚さの半分以下の深さで満加工するようにしている。しかしながら、その場合、半導体ウエハを割るときに結品の方位にもとずく方向性が生じるため、不良品の発生を招くことになる。

このような問題を回避するため、第2の方法として半導体ウエハをその厚さ方向に貫通工造に深たでスクライビング加工するとともに、加工造の発性しないようにする加工方法が考えられている。しかしながら、このような方法によると、半導かりないの周辺部が自近によって垂れ下がる、取扱いが不便である。

そこで、上記第1、第2の方法の欠点を除去するため、半導体ウエハをその厚さの70~80%の深さで満加工することが考えられている。

(発明が解決しようとする課題)

このように、従来はワークに反りが生じると、このワークの上面に対するレーザ光の焦点位置がずれるということがあり、また自動焦点位置合せ装置でレーザ光の焦点位置を追従させるようにしたのでは加工速度が低下するということがあった。

この 危明は上記 当 情にもとずきなされたもので、その目的とするところは、ワークに 反りが生じたならば、その 反りによる レーザ 光の 焦点 位置 のずれを迅速に 補正 してレーザ 加工を 行なえるようにしたレーザ 加工 装置を 提供することにある。

[発明の構成]

(課題を解決するための手段及び作用)

上記課節を解決するためにこの発明は、ワークを保持した保持具と、この保持具を平面上のXY方向に駆動する第1の駆動機構と、レーザ発振器から出力されたレーザ発振器から出力されたレーザ光を集束して上記ワークに照射させる光学系と、この光学系を駆動して上記ワークの上面に対する上記レーザ光の焦点位置を変える第2の駆動機構

しかしながら、このようなスクライピング加工によると、半導体ウエハ1に第6図におけるメカウの海加工を行なうことによってその半導が生たのから、その上面の高さが変化しまう。そのため、メガ向の加工が終了してから、そのと直交するY方向にレーザ光を走査させてスクライピング加工を行なうときに、レーザ光の魚が半導体ウエハの上面に一致しなくなるということがある。

このような問題を除去するためには、自動焦点位置合せ装置を用い、半導体ウエハの反りを測定しながらレーザ光の焦点位置を追従させるということが考えられる。しかしながら、自動焦点位置合せ装置でレーザ光の焦点位置を追従させるには、その都度測定してフィードバックをかけなければならないから、応答時間が長く掛かり、レーザ光の走査を速度で行なうことができず、加工能半の向上に限界が生じる。

と、上記ワークの上面の少なくとも中心部と周辺部の抜数協所との高さを検出する高さ検出器と、この高さ検出器からの検出信号によって上記ワークの上面の全域の高さを演算するとともに、その演算値にもとずいて上記第2の駆動機構を駆動する制御部とを具備する。

このような構成とすることで、ワークの中心部と周辺部の複数値所との高さを測定すれば、そのワークの全域の高さを演算することができるため、その演算値によってレーザ光の焦点位置を制御してレーザ加工を行なうことができる。

(実施弱)

以下、この発明の一実施例を第1図乃至第5 図を参照して説明する。第1図に示すレーザ加工 装置はレーザ電源12が接続されたレーザ発振器 11を確えている。このレーザ発振器11から出 力されたレーザ光しは反射線13で反射して集光 レンズ14に入射し、この集光レンズ14で集束 されて保持具15に保持されたワークとしての半 導体ウェハ1を照射するようになっている。

特開平3-128186(3)

上記保持以15は半導体ウエハ1に比べて十分に小径に形成され、治具17の上面に取付固定されている。この治以17には連通孔18が穿なされている。この連通孔18の一端には図示しない真空ポンプが接続され、他端は上記保持具15の厚さ方向に貫通した吸引孔19に強通している。したがって、上記真空ポンプが作動すると、上記保持具15の上面に閉口した吸引孔19に吸引力が発生するから、それによって保持具15の上面に載置された半導体ウエハ16が吸引保持されるようになっている。

上記治具17は第1の駆動機構21を構成する Yテーブル22上に裁選固定されている。このY テーブル22はメテーブル23上にY方向に移動 目在に設けられ、上記メテーブル23はベース 24上でX方向に移動自在に設けられている。そ して、これらYテーブル22とXテーブル23は 第1の駆動級25によってX、Y方向に駆動され るようになっている。

上記集光レンズ14は駆動ホルダ26に保持さ

によって上記集光レンズ 1 4 の位置決めするとともに、レーザ発張器 1 1 から出力されるレーザ光 Lの出力を半導体ウエハ 1 がその厚さの 70~80% の深さで満加工されるように設定する。

つぎに、第1の駆動機構21によって半導体ウエハ1を駆動し、レーザ光しを半導体ウエハ1の上面で第6図にaで示すように走査させることで、この半導体ウエハ1にX方向に沿ってが定のピッチの満加工をする。それによって、半導体ウエハ1にはその厚さの70~80%の深さで複数の満が所定間で加工されるとともに、そのときの熱応力で第3図に示すようにY方向を中心としてX方向に対して左右がほぼ対称に上昇してV字状の反りが生じる。

このように X 方向のスクライビング 加工が終了したならば、つぎに上記第 1 の 駅動機構 2 1 を作動させて 半専体ウエハ 1 を高さ 校出器 2 9 の下方へ移動させる。そして、この高さ校出器 2 9 によって第 4 図に示すように半導体ウエハ 1 の中心 A と、 X 方向に沿う直径 D, の両端部 B と C および

れていて、このホルダ26は第2の駆動源27に よって上記治具17が移動する平面に対して垂直 なる方向に駆動されるようになっている。つまり、 ホルダ26と第2の駆動級27とで集光レンズ 14を2方向に駆動する第2の駆動機構28を構 成している。また、上記治具17の上方には半導 体ウエハ1の上面の高さを検出するための高さ検 出器29が上記集束レンズ14の側方に配設され ている。この高さ検出器29によって半導体ウエ ハ1の上面の高さが検出されると、その検出信号 は制御部31に人力される。この制御部31は上 記高さ検出器29からの検出信号によって、上記 半導体ウエハ1の上面の全域の高さを後述するご とく演算し、その演算値にもとずいて上記第1の 駆動機構21と第2の駆動機構28とを駆動制御 するようになっている。

っぎに、上記構成のレーザ加工装置で半導体ウエハ1にスクライビング加工する場合について説明する。まず、半導体ウエハ1の上面に集光レンズ14の無点が一致するよう第2の駆動機構28

Y方向に沿う直径 Dェ の両端部 D と E との合計 5 関所の位置における高さが順次検出され、その検 出信号が制御部 3 1 に入力される。

上記制御部31においては、半導体ウエハ1が 直径 D. と D. とによって隔別された4つの部分 1~ IV からなると見なした場合、1の部分の任意 の位置における高さはつぎのような演算式で求め られる。

つまり、第5図に示すように半導体ウエハ1の 半径をR、高さ検出器29によって検出されたC 点とD点との中心Aからの距離をLとし、反りが 直線的であるとすると、イ点と口点における高さ h₁、h₂は、

h = (B-A) · (R/2) + A ··· (1) 式
h = (C-A) · (R/2) + A ··· (2) 式で収まる。

イ点とロ点を直線で結んだ線上で、中心 A から距離 2, の位置のハ点の高さ h g は、(1)式と(2)式より、

特開平3-128186(4)

 $h_1 = (h_1 - h_2) \cdot (R/\rho_1) + h_2 \cdots (3)$ 式で収まる。

また、中心 A から距離 lz の二点の高さ h 4 は、 A 点の高さを a 、 C 点の高さを c とすると、

 $h_4=(c-a)\cdot (\mbox{\it l./l.})+a$ … (4) 式 それによって、中心 A から $\it l._j$ の距離にある任 $\it t$ ②の二点における高さは、

hs = (hs - hs)・(A/L1) + hs… (5) 式で求めることができる。すなわち、反りが生じた半導体ウエハ1の中心Aと周辺部4か所のB~Eの合計5箇所の高さを高さ検出器29で検出すれば、制御部31は上記(1)式~(5)式によって半導体ウエハ1の任意の位置の高さを求めることができるから、それによって全域の反り状態を演算することができる。

このようにして、半導体ウエハ1の反りが演算されると、その演算値にもとずいてが72第2の駆動級27が駆動されながらX方向と直交するY方向のスクライビング加工が行われる。つまり、集光レンズ14は半導体ウエハ1の反り状態に応じ

湖定してフィードバックをかける自動焦点位置合せ装置を用いた場合に比べて加工を能率よく行な うことができる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図はこの発明の一実施例を示す装置全体の既略的構成図、第2 図は同じく半導体ウエハを保持した保持具の断面図、第3 図は同じなく 半導体ウエハの反りが生じた状態の側面図 図 第4 図 は同じく及りが生じた半導体ウエハの高さを測定するのの任意の位置の高さを演算するための説明図、第6 図は半導体ウエハをスクライビング加工するときのレーザ光の走査方法を示した説明図である。

1 1 · · · レーザ発振器、1 4 · · ・ 集光レンズ(光学系)、1 6 · · · 半導体ウエハ(ワーク)、2 1 · · · 第 1 の駆動機構、2 8 · · · 第 2 の駆動機構、2 9 · · · 高 5 校出器、3 1 · · · 制御部。

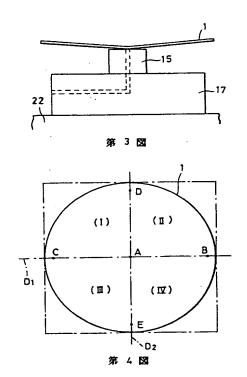
出願人代理人 弁理士 鈴 江武 彦

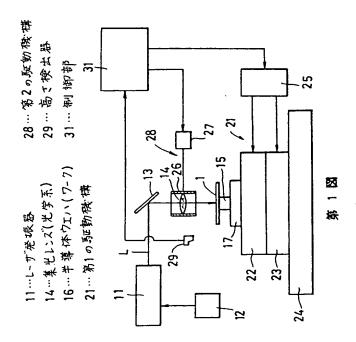
てその焦点がウエハ1の上面に一致するよう高さが制御される。したがって、半導体ウエハ1にX 方向のスクライビング加工をしたのちのY方向のスクライビング加工を確実に、しかも迅速に行なったができる。

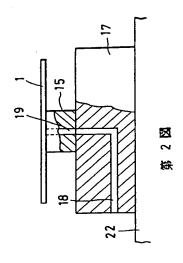
なお、この発明におけるワークは半導体ウエハだけに限られず、それ以外の反りが生じたものに対しても適用することができる。また、集光レンズをワークの上面に無点が一致するよう制御したが、無点位置をワークの上面からずらしてレーザ加工する場合にも適用することができる。

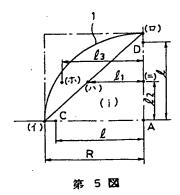
[発明の効果]

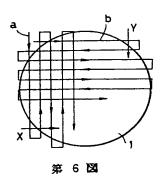
以上述べたようにこの発明によれば、反りがあるワークをレーザ加工する場合に、そのワークの中心部と周辺部の複数遊所との高さを検出部でワークの上面全域の高さを流算をいてレーザ光を集束する光学系を制御するようにした。したがって、反りが生じたワークに対して焦点位置を一定にしていまるにかりか、その都度高











-529-